

デモラインご活用ください スパッタリング装置

Model : SME-200E

◆オプト、実装、MEMS/電子部品、パワー、
通信を含むさまざまなプロセスニーズに対応

特徴

- 2005年製装置をリファーマビッシュ
- Co-sputtering対応
- DC/DC Pulse/RF対応
- Metal/強誘電体/絶縁膜
- 反応性sputtering対応
- ESC-H.P (MAX:500℃) /ガス冷却



膜種

	元素記号
単金属	Ag、Al、Au、Cu、Mo、Ni、Pt、Si、Ta、Ti、W
合金	AlMgCu、AlSi、NiCr、TiN、TiW
非金属	C
酸化物	Si + O ₂
窒化物	AlN、ScAl + N、Si + N、Ta + N、Ti + N、TiW + N

※基板とターゲットは御支給ください
※+表記は反応性スパッタ

ご相談ください

- 成膜試作、検証
- 現象解析
- 操作性確認
- 中古機導入検討

構成

項目	構成
Type	ロードロック式
Chamber構成	P2 : エッチング P3 : 非磁性用Sputter 4元Cathode P4 : Sputter300mmCathode 1式 非磁性 磁性対応
Process P/S	P2 : Bias 0.5kW P3 : DC2kW×2台 ※Co-Sputter可 スパッタUP P4 : RF5kW×1台 DC(パルス)5kW×1台 スパッタDOWN
Stage仕様	P2 : 加熱 MAX300℃ P3 : 加熱 MAX300℃ 回転50rpm P4 : ESC(200,500℃仕様) メカチャック(ガス冷却機構付)
T/S距離(mm)	P3 : 120 P4 : 60
Gas系統	Ar : 100sccm (O ₂ : 100sccm N ₂ : 100sccm P4のみ)
対応基板	P3 : 4インチオリフラ(基板Holder φ220mm) P4 : 8インチノッチ
真空ポンプ	P2 : DRP/TMP P3 : DRP/TMP + CT P4 : DRP/TMP + CT(P3/P4:DRP共用)

ご相談はアルバックテクノへ



SME-200E_1.5

ULVAC